

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成16年7月15日(2004.7.15)

【公開番号】特開2000-206896(P2000-206896A)

【公開日】平成12年7月28日(2000.7.28)

【出願番号】特願2000-31978(P2000-31978)

【国際特許分類第7版】

G 09 F 9/00

G 02 F 1/1343

G 02 F 1/1368

H 01 L 29/786

【F I】

G 09 F 9/00 3 4 8 A

G 09 F 9/00 3 3 8

G 09 F 9/00 3 3 9 Z

G 02 F 1/1343

G 02 F 1/136 5 0 0

H 01 L 29/78 6 1 9 A

【手続補正書】

【提出日】平成15年6月25日(2003.6.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

絶縁表面を有する基板上に形成された薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタの上方に形成された平坦な第一の有機樹脂膜と、
前記第一の有機樹脂膜上に形成された導電膜と、
前記導電膜上に形成された平坦な第二の有機樹脂膜と、
前記第二の有機樹脂膜上に形成された画素電極とを有することを特徴とする電気光学装置
。

【請求項2】

絶縁表面を有する基板上に形成された薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタ上に形成された、酸化珪素又は窒化珪素でなる無機材料膜と、
前記無機材料膜上に形成された平坦な第一の有機樹脂膜と、
前記第一の有機樹脂膜上に形成された導電膜と、
前記導電膜上に形成された平坦な第二の有機樹脂膜と、
前記第二の有機樹脂膜上に形成された画素電極とを有することを特徴とする電気光学装置
。

【請求項3】

絶縁表面を有する基板上に形成された薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタのゲート電極上に形成された、酸化珪素又は窒化珪素でなる第一の
無機材料膜と、
前記第一の無機材料膜上に形成された、ソースバスラインおよびドレインバスラインと、
前記ソースバスラインおよび前記ドレインバスライン上に形成された、酸化珪素又は窒化
珪素でなる第二の無機材料膜と、

前記第二の無機材料膜上に形成された平坦な第一の有機樹脂膜と、
前記第一の有機樹脂膜上に形成された導電膜と、
前記導電膜上に形成された平坦な第二の有機樹脂膜と
前記第二の有機樹脂膜上に形成された画素電極とを有することを特徴とする電気光学装置
。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか一項において、

前記薄膜トランジスタのドレインは、前記画素電極と接続されていることを特徴とする電
気光学装置。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか一項において、

前記導電膜は、一定の電位に保持されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項6】

請求項1乃至5のいずれか一項において、

前記導電膜は、透明導電性被膜よりなることを特徴とする電気光学装置。